SiO₂ 纳米线簇、C-Si-O 纳米球的制备及形貌、 红外光谱和光致发光光谱研究*

郑立仁¹) 黄柏标²⁺ 尉吉勇²)

1 (泰山学院物理与电子科学系,泰安 271021)
2 (山东大学晶体材料国家重点实验室,济南 250100)
(2008 年 7 月 11 日收到 2009 年 4 月 20 日收到修改稿)

以二茂铁和硅油作为催化剂和原料 利用高温裂解硅油为 C Si O 源 在常压 N₂ 和 H₂ 混合气氛的化学气相沉 积管式炉中制备了大量直径为 5—40 nm、长数百纳米的非晶 SiO₂ 纳米线簇及粒径为 100—300 nm 的 C-Si-O 实心纳 米球.利用透射电子显微镜、扫描电子显微镜对产物形貌进行表征.Fourier 红外吸收谱显示出非晶 SiO₂ 所具有的 474 802 和 1100 cm⁻¹三个特征峰 SiO₂ 纳米线簇的光致发光光谱具有较强 440 nm 蓝光发光峰 ;而 C-Si-O 原子数之 比为 1.13:1:2.35)纳米球具有奇特的红绿蓝(625 540 466 nm)三色光致发光谱.

关键词:SiO₂ 纳米线簇, C-Si-O 纳米球, 高温裂解, Fourier 红外谱 PACC:7855

1.引 言

纳米管、纳米带和纳米球等纳米材料,由于具有 优越的机械、物理、化学性能及潜在的应用价值而备 受关注^[1-5].近 20 年来,纳米材料的制备研究取得 了显著的进展,Si 纳米线、多孔 Si 及纳米 Si 等 Si 纳 米材料的制备以及发光性能的研究也已成为研究的 热点之一^[6-10].本文利用化学气相沉积(CVD)高温 裂解法,在石英管的不同区域获得了大量 SiO₂ 纳米 线簇和 C-Si-O 纳米球,并研究了它们的红外和光致 发光(PL)性质.

分别用 S-4800 型扫描电子显微镜(SEM), JEM-100CX [] 型透射电子显微镜(TEM), NEXUS-670 型 Fourier 变换红外(FTIR)光谱仪和 FLS-920 型 PL光 谱仪对产物的形貌、组分及结晶性等性质进行了表 征和研究.

2.实验

把装有适量二茂铁、硅油和苯的石英舟放入石

英管中(见图 1(a)(b)),使 1 号槽和 2 号槽处于温 区 \Box 中心.以 N₂ 和 H₂(H₂ 的摩尔含量为 5.06%)的 混合气体作为保护气体,整个实验过程中载气流量 为 100 ml/min 左右.温区 \Box 和温区 \Box 在 110 min 内 分别 升 到 300 和 1100℃,保温 2 h 后继续以 100 ml/min的流量通气降温,降至室温时取出石英管 并收集样品.

3. 实验结果与讨论

3.1. 形貌表征

按石英管在管式炉内的位置,把石英管分成八 个区域,每个区域长为20 cm(图1(c)).

石英管壁上的产物有三层,从管壁向管轴产物 的颜色依次为灰黑色、米黄色和白色.石英管上方的 白色物是一层膜;灰黑色与米黄色的产物都为粉末 状,贴近石英管内壁的灰黑色粉末是二茂铁、硅油裂 解后生成的无定形碳.对米黄色粉末及白色膜进行 测试发现:米黄色粉末是直径为 100—300 nm 的实

^{*} 国家重点基础研究发展计划:批准号 2007CB613302 和国家自然科学基金(批准号 50721002,10774091)资助的课题.

[†] 通讯联系人. E-mail:bbhuang@sdu.edu.cn



图 1 实验装置中分区示意图 (a)石英管内石英舟中各组分 (b)石英管内石英舟的位置及气体流动方向 (c)石英管内的区域划分



图 2 石英管不同位置产物的 TEM 照片 (a)区域 7 处白色膜 (b)区域 1 处白色膜 (c)区域 1 和区域 3 处白色膜 , (d)区域 8 处的产物

心纳米球(图2(d)),这些纳米球的表面光滑,大部 分粘连在一起(在硅油和二茂铁为原料的实验中是 主要形貌),其成分是C_Si,O_相应的原子数之比为 1.13:1:2.35(摩尔分数分别为25.28%,22.33%, 52.39%);而白色膜则是SiO₂纳米线簇(图2(a)— (c)和图3),且以同一中心生长,每根纳米线的直径 在5—20 nm之间,长为数百纳米.

图 2 是石英管不同区域产物的 TEM 照片.图 2

(b)和(c)中纳米线的形貌较好,这说明区域1和区域3是SiO2纳米线簇生长的最佳区域.图(c)内右上方是SiO2纳米线选区电子衍射照片,这是一个典型的非晶电子衍射图,说明SiO2纳米线是非晶的. 图(b)中每根SiO2纳米线上都有许多直径小于10 nm的SiO2纳米线,且每条纳米线的端头都有黑色催化剂颗粒,表明SiO2纳米线的生长遵循气相-液相-固相机制.

处的形貌好,同时还显示纳米线的直径在 20-50 nm 间,这与纳米线的 TEM 照片(图 χ a)-(c))一致.



图 3 石英管不同位置产物的 SEM 照片 (a)区域 1 处白色膜低倍照片 (b)区域 1 处白色膜高倍照片 (c)区域 7 处白色膜低倍照片 (d)区域 7 处白色膜高倍照片

3.2. FTIR 谱及 PL 谱

图 4 是石英管不同区域白色膜的 FTIR 谱.图 4 显示非晶 SiO₂ 簇在 400—2000 cm⁻¹间的横向光学声 子伸缩振动峰^[11-13]:474 cm⁻¹处为 Si—O—Si 的摇 摆振动吸收峰 802 cm⁻¹处为 O—Si—O 的伸缩振动 吸收峰,1100 cm⁻¹处为 Si—O 非对称伸缩振动吸收 峰.红外谱中 550 cm⁻¹处的吸收峰是 Fe—O 键的伸缩 振动吸收峰.石英管中区域 1 和区域 3 处白色膜在 1100 cm⁻¹处的吸收峰明显宽化、峰强也相应减弱.这 是因为不同区域的温度、生长源浓度等不同所致.

PL 谱如图 5 所示,区域 1 和区域 5 处白色膜的 PL 谱中 540 和 623 cm⁻¹处的峰很弱.在测试区域 1 和区域 5 处的样品时,加了截止波长为 420 nm 的滤 光片,并将其结果与没加滤光片的进行了对比(见图 5(a 和(b)).从图 5(a 和(b)可以看出,加滤波片后 的曲线成了一光滑的曲线,而 560,623 nm 等处的峰 消失,只有 440 nm 左右的一个峰,且峰强略有减弱.



图 4 不同区域白色膜的 TTIR 谱

图 2 中 TEM 照片显示,区域 1 处比区域 7 处纳米线 的成形好,而相应产物的 440 nm 处 PL 峰相应增强, 该峰是 SiO₂ 纳米线簇的荧光峰^[14].图 5(c)是区域 7 和区域 8 处产物的 PL 谱,这与该样品的 TEM 照片 显示一致,即在区域 8 处的产物中 C-Si-O 实心纳米 球是其主产物而纳米线的量很少,而区域 7 处有大



图 5 产物的 PL 谱 激发波长均为 360 nm.(a) 区域 1 处的膜, (b) 区域 5 处的膜(c) 区域 7 和区域 8 处的产物

量的 SiO₂ 纳米线,但成形都不太好.因此区域 7 处 产物位于 440 nm 处的峰强比区域 8 处产物的峰强 更强,而其他几个峰(460,535 与 622 nm)的强度则 要弱些.如图 5(e)所示,C-Si-O 实心纳米球的 PL 谱 结果显示了其具有 460,535 和 622 nm 三色的荧光 峰.这种纳米球是本实验的主产物,其发光机制有 待进一步研究.

3.3. 结果讨论

在 CVD 系统中,物质在高温条件下裂解,反应 物和催化剂都是气态,因此容易生长高质量的纳米 材料,且纳米材料的尺寸较小.本实验利用高温裂解 硅油方法生长的 SiO₂ 纳米线,其直径仅有 10— 40 nm,部分纳米线的直径还要小于 10 nm.在实验中 所用的原料比较多,这为纳米材料的生长机理的探 讨增加了困难.不过,SiO₂ 纳米线簇的生长与苯没有 关系.因为本实验升温速率小,且两个温区分别平稳 升温,而苯又是挥发性极高的物质,在 110 min 内几 乎挥发殆尽.在以硅油为原料(没有苯)的产物中,只 有少量的灰黑色产物,大部分是米黄色的产物;有苯 参与的实验中所含的灰黑色产物增加,而且测试结 果中没有发现有新的产物出现.所以苯的添加仅增 加无定形碳的相对量.

石英管的区域 1—区域 5 是生长 SiO₂ 纳米线簇 的较佳区域.区域 3 和区域 4 的温度相差不多,因 此在这两个区域产物的形貌应该一样,这种推测在 实验结果中基本得到验证.区域 5 的温度要比区域 3 和区域 4 的温度高,其生长的纳米线形貌不是很 好,而区域 7 和区域 8 处则不利于纳米线的生长.

C-Si-O 实心纳米球是本次实验的主要产物.我 们认为在高温下二茂铁首先分解生成无定形碳和气 态的纳米铁颗粒,随着炉温的升高并到达 1100℃, 硅油开始裂解,在催化剂铁的存在下,很容易生成 C-Si-O 纳米球产物.正因为石英管中温度的分布有一 定的梯度,所以在管壁不同位置沉积的 C-Si-O 纳米 球的直径和结晶性不是很一致,这直接影响 C-Si-O 纳米球的发光等性质.对 C-Si-O 纳米球的生长机理 及性质有待进一步的研究.

4.结 论

利用 CVD 方法,通过简单的高温裂解硅油,获 得大量非晶 SiO₂ 纳米线簇及实心 C-Si-O 纳米球. C-Si-O实心纳米球的荧光谱具有独特的红蓝绿三色 峰,说明 C-Si-O 纳米球的 PL 谱涵盖了整个可见光 波段.这是一种潜在的白光荧光物质,在下一代固体 白光照明工程中具有潜在应用价值.



- [1] Chen X ,Gao X P Zhang H Zhou Z ,Hu W K ,Pan G L ,Zhu H Y , Yan T Y Song D Y 2005 J. Phys. Chem. B 109 11525
- [2] Hiroki I , Toshiro H 1997 Appl. Phys. Lett. 71 3691
- [3] Huang Y ,Duan X F ,Cui Y 2001 Science 294 1313
- [4] Zhou X T ,Hu J Q ,Li C P ,Ma D D ,Lee C S ,Lee S T 2003 Chem . Phys. Lett. 369 220
- [5] Tang Y H Sun X H Au F C K Liao L S Peng H Y Lee C S Lee S T Sham T K 2001 Appl. Phys. Lett. 79 1673
- [6] Tang Y H Zhang Y H Peng H Y Wang N Lee C S Lee S T 1999 Chem. Phys. Lett. 314 16
- [7] Zhang J Jiang F D , Yang Y D JLi J P 2007 J. Crys. Growth 307 76
- [8] Xia Z D Zhang L D ,Meng G W ,Tian X K ,Zeng H B ,Fang M 2006

J. Phys. Chem. B 110 15724

- [9] Zhao Y Li D S Zha J Sang W B ,Yang D R Jiang M H 2008 Curr. Appl. Phys. 8 206
- [10] Liang J J, Wang Y Q, Chen W D, Wang Z G, Chang Y 2000 Acta Phys. Sin. 49 1386 (in Chinese)[梁建军、王永谦、陈维德、王 占国、常 勇 2000 物理学报 49 1386]
- [11] Bell J ,Dean P 1970 Discuss. Faraday Soc. 50 55
- [12] Sen P N ,Thorpe M F 1977 Phys. Rev. B 15 4030
- [13] Galeener F L 1979 Phys. Rev. B 19 4292
- [14] Zheng L R, Huang B B, Wei J Y 2009 Acta Phys. Sin. 58 2306(in Chinese)[郑立仁、黄柏标、尉吉勇 2009 物理学报 58 2306]

Synthesis of silicon oxide nanocluster and C-Si-O nanospheres morphology and photoluminscence Fourier transform infrared spectroscopy study*

Zheng Li-Ren¹) Huang Bai-Biao²)[†] Wei Ji-Yong²)

1 X Department of Physics and Electronics ,Taishan University ,Tai'an 271021 ,China)

2 X State Key Laboratory of Crystal Materials ,Shandong University ,Jinan 250100 ,China)

(Received 11 July 2008; revised manuscript received 20 April 2009)

Abstract

Silicon oxide nanocluster and C-Si-O nanospheres are fabricated by the chemical vapor deposition method at 1100° C, in flowing N₂/H₂ atmosphere using the ferrcene and the silicon oil (201) as the raw material and the catalyzer, respectively. The silicon oxide nanowires are uniform with diameter of 5—40 nm and length up to hundreds of nanometer. The diameter of the C-Si-O solid-nanospheres is 100—300 nm. Scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, electronic data system, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and photoluminscence (PL) were used to characterize the microstructure, composition and optical properties of the nanocluster and the C-Si-O nanospheres. Energy dispersive x-ray spectrum analysis reveals that the C-Si-O nanospheres consist of C Si and O elements in an atomic ratio of approximately 1.13: 1:2.35. The nanoclusters show infrared spectroscopy absorption peaks at 474,802 and 1100 cm⁻¹. The PL peak of the nanoclusters is at 440 nm. It is very curious that the PL of the C-Si-O solid-nanospheres possesses the red green and blue—trichromic luminescent peeks.

Keywords : silicon oxide nanocluster , C-Si-O nanospheres , pyrolysics , Fourier transform infrared spectroscopy spectrum PACC : 7855

^{*} Project supported by the State Key Development Program for Basic Research of China (Grant No. 2007CB613302) and the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 50721002, 10774091).

[†] Corresponding author. E-mail: bbhuang@sdu.edu.cn